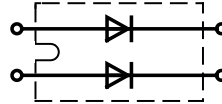


Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED)

$$\begin{aligned} I_{FAVM} &= 2 \times 71 \text{ A} \\ V_{RRM} &= 200 \text{ V} \\ t_{rr} &= 35 \text{ ns} \end{aligned}$$

V_{RSM} V	V_{RRM} V	Type
200	200	DSEI 2x 61-02A



miniBLOC, SOT-227 B



E72873

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings (per diode)	
I_{FRMS}	$T_{VJ} = T_{VJM}$	100	A
I_{FAVM} ①	$T_C = 85^\circ\text{C}$; rectangular, $d = 0.5$	71	A
I_{FRM}	$t_P < 10 \mu\text{s}$; rep. rating, pulse width limited by T_{VJM}	800	A
I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	950	A
	$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	1020	A
	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	800	A
	$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	870	A
I^2t	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	4500	A^2s
	$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	4300	A^2s
	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	3200	A^2s
	$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	3140	A^2s
T_{VJ}		-40...+150	$^\circ\text{C}$
T_{VJM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-40...+150	$^\circ\text{C}$
P_{tot}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	150	W
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	2500	V~
M_d	Mounting torque	1.1-1.5/9-13	Nm/lb.in.
	Terminal connection torque (M4)	1.1-1.5/9-13	Nm/lb.in.
Weight		30	g

Features

- International standard package miniBLOC (ISOTOP compatible)
- Isolation voltage 2500 V~
- 2 independent FRED in 1 package
- Planar passivated chips
- Very short recovery time
- Extremely low switching losses
- Low I_{RM} -values
- Soft recovery behaviour

Applications

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Anti saturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode in converters and motor control circuits
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Inductive heating and melting
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Ultrasonic cleaners and welders

Advantages

- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching
- Low losses
- Operating at lower temperature or space saving by reduced cooling

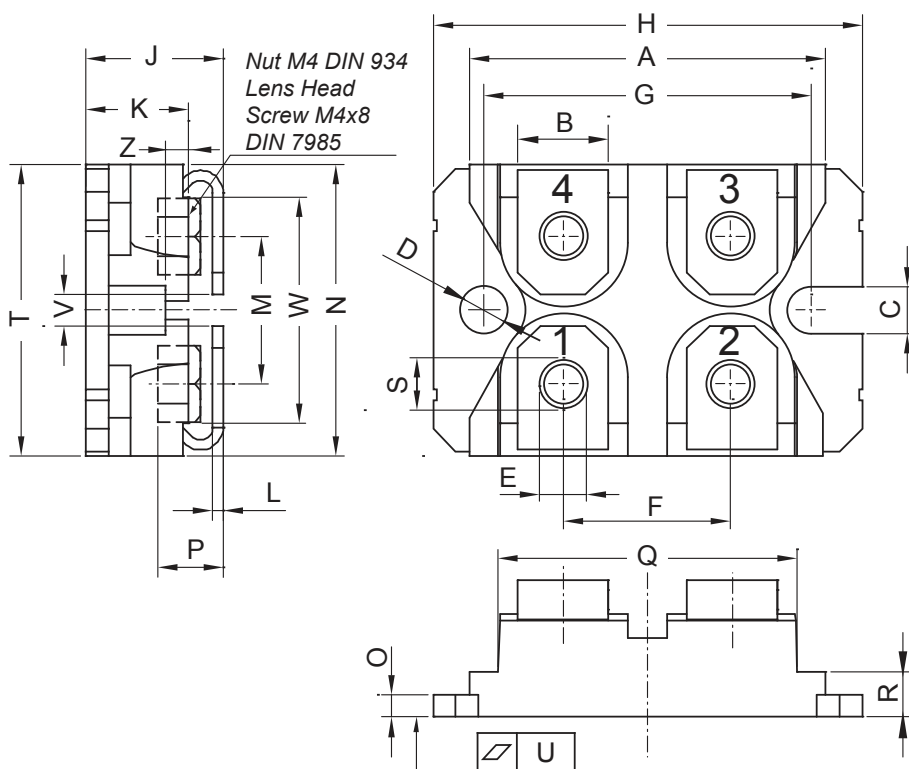
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (per diode)	
		typ.	max.
I_R	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	50 μA
	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$	40 μA
	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	$V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$	11 mA
V_F	$I_F = 60 \text{ A}$; $T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		0.88 V 1.08 V
V_{T0}	For power-loss calculations only		0.7 V
r_T	$T_{VJ} = T_{VJM}$		3.0 m Ω
R_{thJC}			0.8 K/W
R_{thCK}		0.05	K/W
t_{rr}	$I_F = 1 \text{ A}$; $-di/dt = 200 \text{ A}/\mu\text{s}$; $V_R = 30 \text{ V}$; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	35	50 ns
I_{RM}	$V_R = 100 \text{ V}$; $I_F = 60 \text{ A}$; $-di_F/dt = 200 \text{ A}/\mu\text{s}$ $L \leq 0.05 \text{ mH}$; $T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$	8	10 A

① I_{FAVM} rating includes reverse blocking losses at T_{VJM} , $V_R = 0.8 V_{RRM}$, duty cycle $d = 0.5$
Data according to IEC 60747

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

20170315a

miniBLOC, SOT-227 B



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	37.80	38.23	1.488	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.74	0.84	0.029	0.033
M	12.50	13.10	0.492	0.516
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.95	2.13	0.077	0.084
P	4.95	6.20	0.195	0.244
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.167
S	4.55	4.85	0.179	0.191
T	24.59	25.25	0.968	0.994
U	-0.05	0.10	-0.002	0.004
V	3.20	5.50	0.126	0.217
W	19.81	21.08	0.780	0.830
Z	2.50	2.70	0.098	0.106

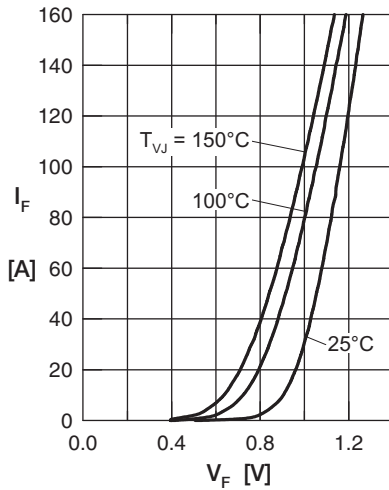


Fig. 1 Forward current I_F versus V_F

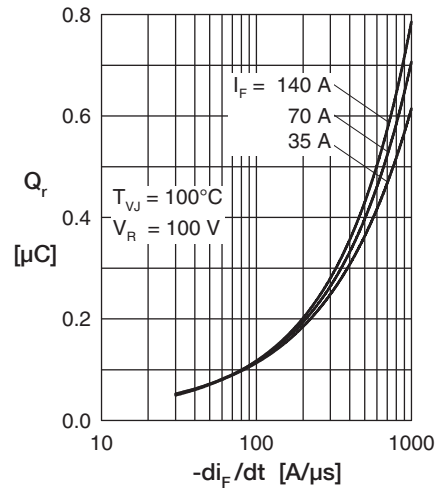


Fig. 2 Typ. reverse recov. charge Q_{rr} versus $-di_F/dt$

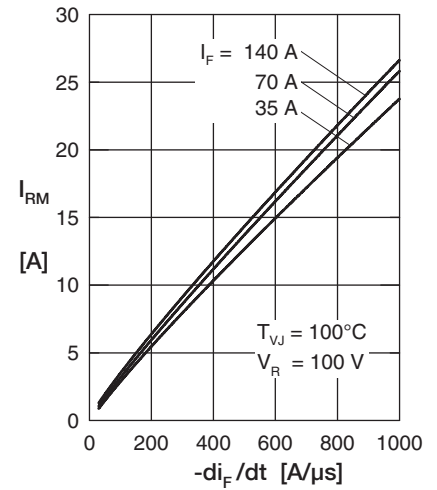


Fig. 3 Typ. peak reverse current I_{RM} versus $-di_F/dt$

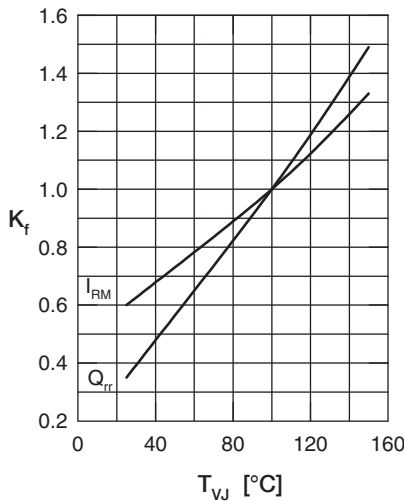


Fig. 4 Dyn. parameters Q_{rr} , I_{RM} versus T_{VJ}

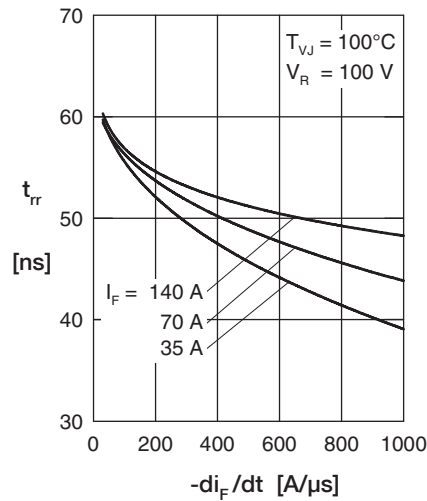


Fig. 5 Typ. recovery time t_{rr} versus $-di_F/dt$

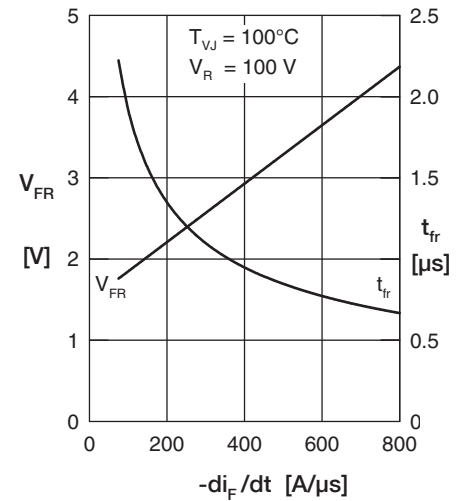


Fig. 6 Typ. peak forward voltage V_{FR} and t_{fr} versus di_F/dt

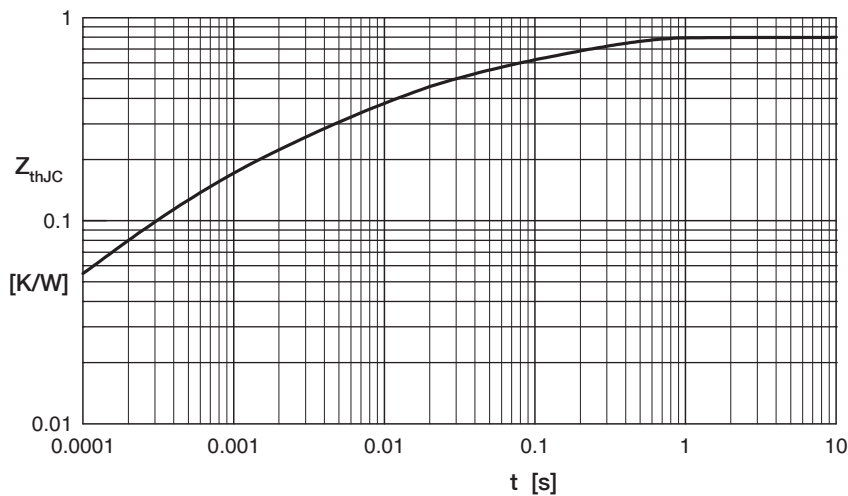


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} [K/W]	t_i [s]
1	0.1000	0.00014
2	0.3400	0.00600
3	0.3600	0.16500

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9